

Э Т И К Е Т К А



Полупроводниковые интегральные микросхемы
198НТ1А, 198НТ1Б, 198НТ2А, 198НТ2Б, 198НТ3

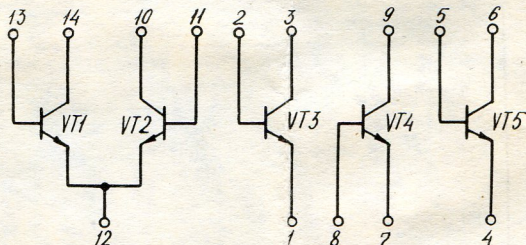
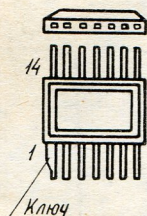
"Матрица транзисторов п-р-п типа"

Основное назначение: предназначена для построения широкого набора функциональных схем вычислительной и электроизмерительной техники, автоматики и телемеханики, аппаратуры спецназначения, усилителей низкой и высокой частоты, дифференциальных и операционных усилителей, усилителей постоянного тока, балансных схем, генераторов колебаний импульсной и синусоидальной формы, ключевых и коммутационных схем и др.

Схема

Схема электрическая принципиальная для 198НТ1

расположения выводов



Для 198НТ2 - без транзистора VT4

Для 198НТ3 - без транзистора VT1

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ПОСТАВКЕ (ПРИ $T_{окр} 25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Наименование параметра	Норма					
	198НТ1А 198НТ2А		198НТ1Б 198НТ2Б		198НТ3	
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, $h_{21Э}$, при $U_{КБ}=3\text{В}$, $I_Э=0,5\text{мА}$	30	200	30	200	30	200
Обратный ток коллектора, $I_{КБО}$, при $U_{КБ}=6\text{В}$, $I_Э=0,5\text{мА}$	-	0,05	-	0,05	-	0,05
Напряжение насыщения база-эмиттер, $U_{БЭнас}$, при $I_К=3\text{мА}$, $I_Э=0,5\text{мА}$, В	-	0,8	-	0,8	-	0,8
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, $U_{КЭнас}$, при $I_К=3\text{мА}$, $I_Э=0,5\text{мА}$, В	-	0,4	-	0,4	-	0,4
Разброс статических коэффициентов передачи тока транзисторов дифференциальной пары, $\delta h_{21Э}$, при $U_{КБ}=3\text{В}$, $I_Э=0,5\text{мА}$, %	-	15	-	15	-	-
Разброс напряжения между базой эмиттером транзисторов дифференциальной пары, $\delta U_{БЭ}$, при $I_Э=0,5\text{мА}$, $U_{КБ}=3\text{В}$, мВ	-	3	-	10	-	-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Постоянное напряжение коллектор-база, $U_{КБ}$ пред. В	-	15
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭР}$ пред. В	-	15
Обратное напряжение база-эмиттер, $U_{ЭБ0}$ пред. В	-	-4
Обратное напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭ0}$ пред. В	-	15
Постоянный ток коллектора, I_K пред. мА	-	10
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения, I_K нас. пред. мА	-	30
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T=25 \pm 10^\circ\text{C}$ - одним транзистором $P_{к.пред}$ мВт	20	-
- матрицей P пред. мВт	100	-
при температуре до $+85^\circ\text{C}$ - одним транзистором $P_{к.пред}$ мВт	20	-
- матрицей P пред. мВт	80	-
при температуре до $+125^\circ\text{C}$ - одним транзистором $P_{к.пред}$ мВт	10	-
- матрицей P пред. мВт	50	-
Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$	-60	+125

Содержание драгоценных металлов в одной микросхеме

"Золото" мг

25,8302мг-3л.999,9

198 НТЗ

Микросхема соответствует техническим условиям

О.348.002 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

МАР 1978

Место для штампа

Место для штампа

ОТК

представителя заказчика

Технические условия О.348.002 ТУ.

Ред. 2-76

